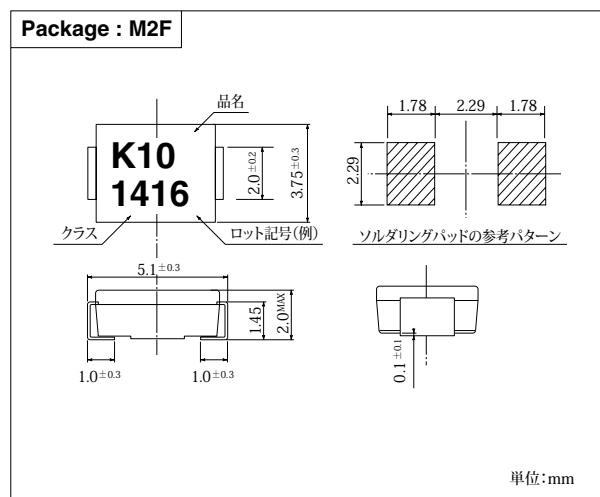


**KU10N14**

140V100A

## ■外形寸法図 OUTLINE DIMENSIONS



外形図については新電元 Web サイト又は〈半導体製品一覧表〉をご参照下さい。捺印表示については捺印仕様をご確認下さい。

For details of outline dimensions, refer to our web site or the Semiconductor Short Form Catalog. As for the marking, refer to the specification "Marking, Terminal Connection."

## ■定格表 RATINGS

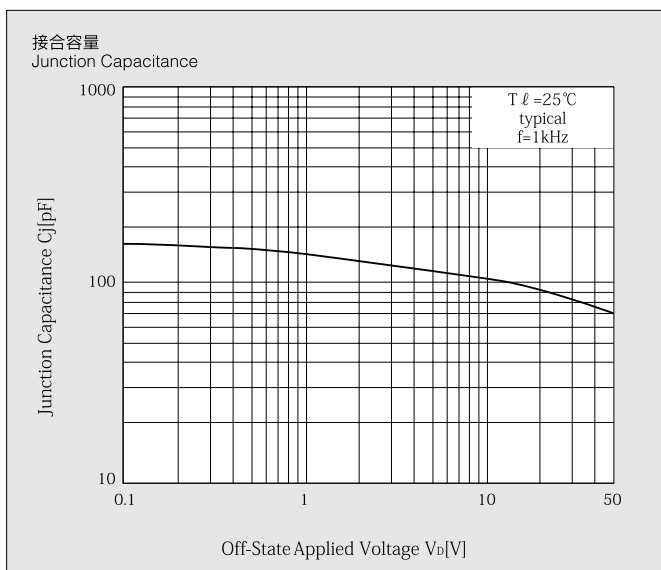
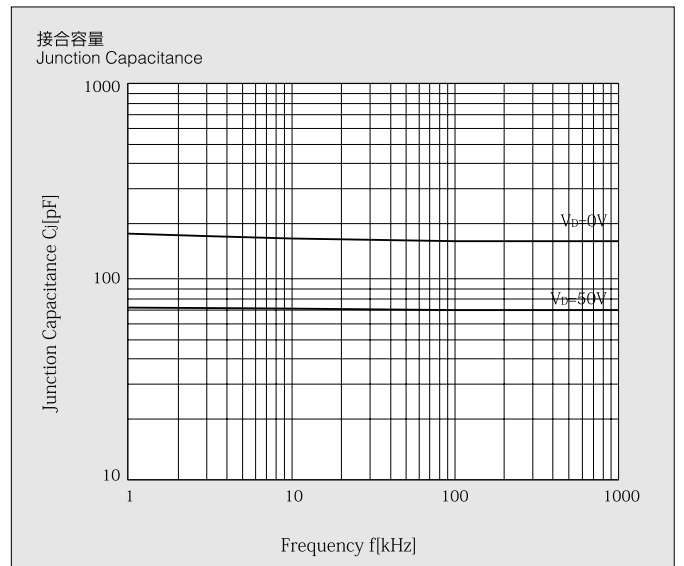
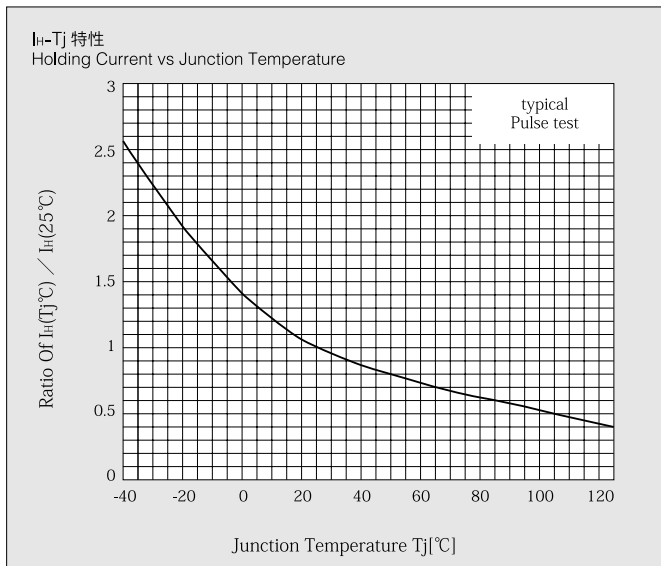
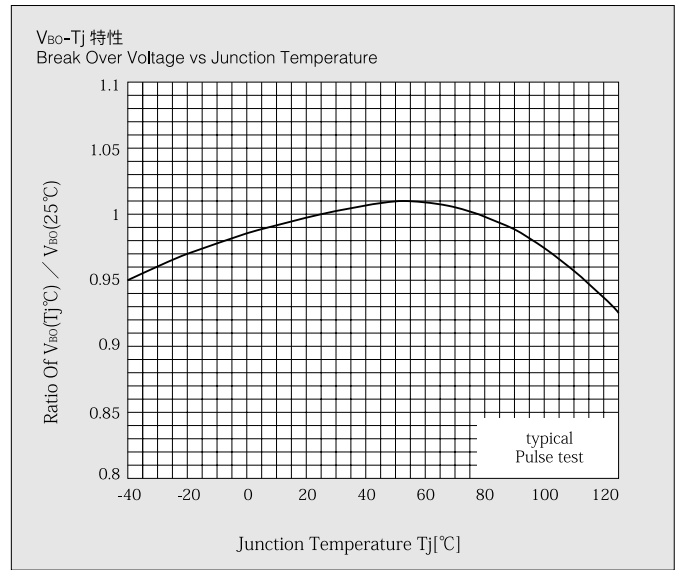
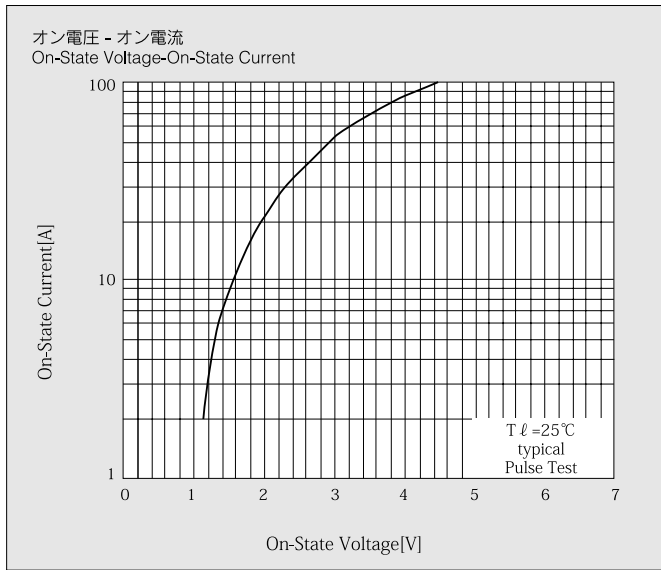
●絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings (指定のない場合  $T_1=25^\circ\text{C}$  / unless otherwise specified)

項目 Item	記号 Symbol	条件 Conditions		規格値 Ratings	単位 Unit
保存温度 Storage Temperature	Tstg			-40~125	°C
接合部温度 Junction Temperature	Tj			125	°C
オフ電圧 Maximum Off-State Voltage	VDRM			120	V
せん頭サージ電流 Surge On-State Current	ITSM	10/1000 $\mu\text{s}$	非繰り返し Non-repetitive	100	A

●電気的特性  $T_c=25^\circ\text{C}$  Electrical Characteristics  $T_c=25^\circ\text{C}$  (指定のない場合  $T_1=25^\circ\text{C}$  / unless otherwise specified)

ブレイクオーバー電圧 Breakover Voltage	VBO	dv/dt=8V/ms	MIN 125	V
オフ電流 Off-State Current	IDRM	$V_D=V_{DRM}$	MAX 5	$\mu\text{A}$
保持電流 Holding Current	I <sub>H</sub>	パルス測定 Pulse measurement	MIN 100	mA
オン電圧 On-State Voltage	V <sub>T</sub>	I <sub>T</sub> =2A	MAX 3.0	V
接合容量 Junction Capacitance	C <sub>j</sub>	f=1kHz $V_D=50\text{V}$	MAX 140	pF
クランピング電圧 Clamping Voltage	V <sub>CL</sub>	dv/dt=100V/ $\mu\text{s}$	MAX 195	V

■特性図 CHARACTERISTIC DIAGRAMS



- \* Sine wave は 50Hz で測定しています。
- \* 50Hz sine wave is used for measurements.
- \* 半導体製品の特性は一  
Typical は統計的な実力を表しています。
- \* Semiconductor products generally have characteristic variation.  
Typical a statistical average of the devices ability.